

# Institut für Mikro- und Nanoelektronische Systeme

Leiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. Michael Siegel

Hertzstr. 16 D-76187 Karlsruhe

Telefon: +49 608 44961
Fax: +49 757925
E-Mail: info@ims.kit.edu
Web: http://www.ims.kit.edu

# Aufgaben zum Tutorium 2 "Elektronische Schaltungen" SS 2012

Gegeben ist das Kennlinienfeld (Bild 7.1) eines npn-Transistors. Der Transistor wird in einer Schaltung nach Bild 7.2 betrieben. Der Arbeitspunkt liegt bei  $U_{CE} = 10 \text{ V}$ ,  $I_{C} = 37,5 \text{ mA}$ .

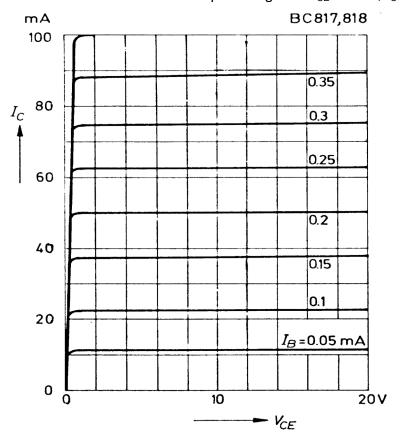


Bild 7.1

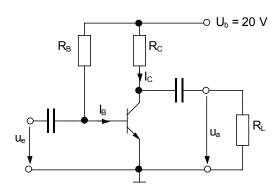


Bild 5.2

- 7.1 Bestimmen Sie aus dem Kennlinienfeld die Stromverstärkung B des Transistors im angegebenen Arbeitspunkt!
- 7.2 Welchen Wert muss der Widerstand  $R_{\rm C}$  haben, damit der Arbeitspunkt eingestellt werden kann? Tragen Sie die Lastgerade für  $R_{\rm C}$  in das Kennlinienfeld ein!
- 7.3 Berechnen Sie den Widerstandswert von R<sub>B</sub> für den angegebenen Arbeitspunkt!
- 7.4 Wie ändert sich die Lastgerade bei Wechselstrombetrieb, wenn der Lastwiderstand  $R_L = R_C$  ist ?
- 7.5 Berechnen Sie die Verstärkung A =  $u_a / u_e$  der Schaltung!

Gegeben sei eine Schaltung nach Bild 8.1. Der Transistor habe eine Stromverstärkung von  $\beta$  = B = 150 .

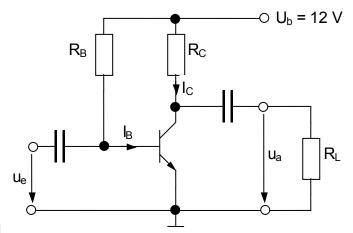


Bild 8.1

- 8.1 In welcher Grundschaltung wird der Transistor betrieben?
- 8.2 Skizzieren Sie das Großsignalersatzschaltbild für die Schaltung in Bild 8.1!
- 8.3 Skizzieren Sie das Kleinsignal-Ersatzschaltbild für die Schaltung in Bild 8.1!
- 8.4 Zur Einstellung des Arbeitspunktes der Schaltung soll ein Basisstrom von  $9\mu A \le I_B \le 10\mu A$  zugelassen werden. Bestimmen Sie den dazu notwendigen Wert des Basisvorwiderstands  $R_B$  aus der E24 Widerstandsreihe!
- 8.5 Der Arbeitspunkt der Schaltung soll bei einer Kollektor-Emitter-Spannung  $U_{CE} \approx 6.0 \text{ V}$  liegen. Berechnen Sie den Wert des Widerstands  $R_{C}$  (E24 Reihe) der dieser Forderung am nächsten kommt !
- 8.6 Berechnen Sie die Steilheit S für die Schaltung mit den in 8.4 und 8.5 ermittelten Widerstandswerten!
- 8.7 An den Eingang wird eine Wechselspannung  $u_1$  angelegt. Bestimmen Sie den Eingangswiderstand  $r_e$  der Schaltung!
- 8.8 Berechnen Sie die Spannungsverstärkung der Schaltung A =  $u_a / u_e$  für folgende zwei Fälle: a) Leerlauf am Ausgang ( $R_L = \infty$ ) und b)  $R_L = R_C$ !

Gegeben ist eine Transistorschaltung nach Bild 9.1. Der Transistor habe eine Stromverstärkung von  $\beta$  = B = 400. Die Kondensatoren können für Wechselstrom als Kurzschluss betrachtet werden. Die Widerstände haben folgende Werte:  $R_{V1}$  = 9,1 k $\Omega$ ,  $R_{V2}$  = 3,9 k $\Omega$ ,  $R_{C}$  = 1,2 k $\Omega$ ,  $R_{E}$  = 1 k $\Omega$ ,  $R_{L}$  = 6 k $\Omega$  ( Annahme:  $I_{B}$  <<  $I_{q}$ )

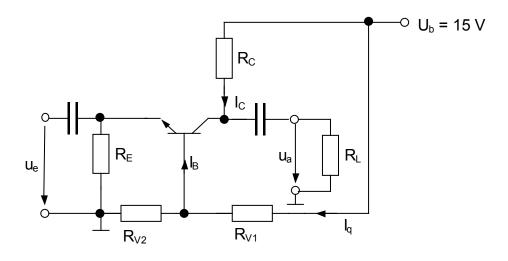
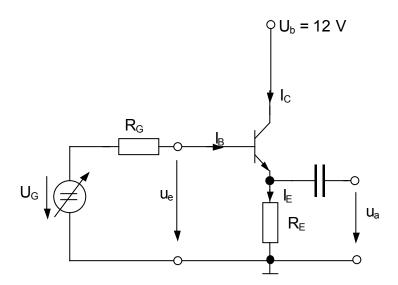


Bild 9.1

- 9.1 In welcher Grundschaltung wird der Transistor betrieben?
- 9.2 Skizzieren Sie das Großsignalersatzschaltbild für die Schaltung in Bild 9.1!
- 9.3 Skizzieren Sie das Kleinsignal-Ersatzschaltbild für die Schaltung in Bild 9.1!
- 9.4 In welchem Arbeitspunkt wird der Transistor betrieben ?
- 9.5 Berechnen Sie die Spannungsverstärkung A der Schaltung!
- 9.6 Berechnen Sie den Eingangswiderstand r<sub>e</sub> der Schaltung!
- 9.7 Berechnen Sie den Ausgangswiderstand r<sub>a</sub> der Schaltung!

Die Eingangsstufe eines Mikrofonverstärkers soll durch eine Transistorschaltung nach Bild 10.1 realisiert werden. Der Transistor hat eine Stromverstärkung von  $\beta$  = B = 200. Die Kondensatoren können für Wechselstrom als Kurzschluss betrachtet werden. Die Widerstände haben folgende Werte:  $R_G$  = 100 k $\Omega$ ,  $R_E$  = 2 k $\Omega$ . Der Basisstrom beträgt  $I_B$  = 10  $\mu$ A.



**Bild 8.1** 

- 10.1 In welcher Grundschaltung wird der Transistor betrieben?
- 10.2 Skizzieren Sie das Kleinsignal-Ersatzschaltbild für die Schaltung in Bild 10.1!
- 10.3 Berechnen Sie den Eingangswiderstand r<sub>e</sub> und den Ausgangswiderstand r<sub>a</sub> der Schaltung!
- 10.4 Berechnen Sie die Spannungsverstärkung A der Schaltung!

### **Gruppenaufgabe im Tutorium G1:**

Sie haben in der Vorlesung Bipolar- und Feldeffekttransistoren kennengelernt.

Welchen Transistortyp, bzw. welche Grundschaltung würden Sie für die folgenden Anwendungen verwenden? Diskutieren Sie in kleinen Gruppen! Nehmen Sie zu Recherchezwecken Ihr Skript und vergleichen Sie Parameter, wie Geschwindigkeit, Stromverbrauch, Steilheit, Flächenverbrauch,...

- Verstärker für ein Hochfrequenzsignal bei mehreren GHz.
- Ausgangstreiberstufe eines IC, belastbar mit mehreren mA.
- Digitales IC f
  ür Taktraten im MHz Bereich.
- Antennenverstärker mit hoher Verstärkung.

Sie bekommen als Projektauftrag, eine Stromquelle zu designen.

Dafür sollen Sie den Linearregler LM234 von Texas Instruments (ehemals National Semiconductor) verwenden. **Organisieren Sie sich bei der Herstellerseite, bzw. durch Internetrecherche das Datenblatt des LM234**.

- 11.1 Wie groß ist laut Datenblatt der maximale Strom, der durch den Baustein zur Verfügung gestellt werden kann?
  Wie viel Verlustleistung verträgt der Baustein maximal?
- 11.2 Entwickeln Sie mit Hilfe der Angaben und Schaltungsvorschläge im Datenblatt eine Stromquelle, die bei 25°C aus 12 V Eingangsspannung 1 mA Ausgangsstrom bereitstellt. Berechnen Sie die nötigen Bauteilwerte!

Analysieren Sie mit Hilfe der "Typical Performance Characteristics" Diagramme aus dem Datenblatt folgende Parameter:

- 11.3 Welche maximale Änderungsgeschwindigkeit (Slewrate) der Ausgangsspannung bei geänderter Last kann erreicht werden, wenn der Baustein mit 1 mA belastet wird.
- 11.4 Wie lange dauert die Einschwingzeit beim Einschalten des Linearreglers bei 1mA Last?





Hertzstr. 16 D-76187 Karlsruhe

Telefon: +49 608 44961
Fax: +49 757925
E-Mail: info@ims.kit.edu
Web: http://www.ims.kit.edu

## Lösungen zum Tutorium 2 in Elektronische Schaltungen

Name:	Vorname:	Matr.Nr.:	
Cruppo			
Gruppe:			

Lösung Aufgabe 9.1 bis 9.3 Aufgabe 11